

Power MOSFET

P4F60HP2

600V 4A

特長

- 高耐圧
- 低オン抵抗
- 高速スイッチング
- 高アバランシェ耐量、高 di/dt 耐量

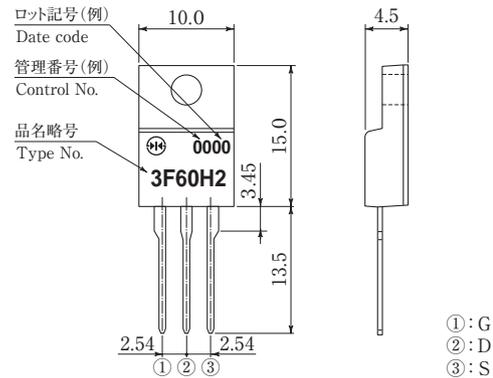
Feature

- High Voltage
- Low R_{ON}
- Fast Switching
- High Avalanche durability, High di/dt durability

■ 外観図 OUTLINE

Package : FTO-220AG (3pin)

Unit : mm



外形図については新電元 Web サイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■ 定格表 RATINGS

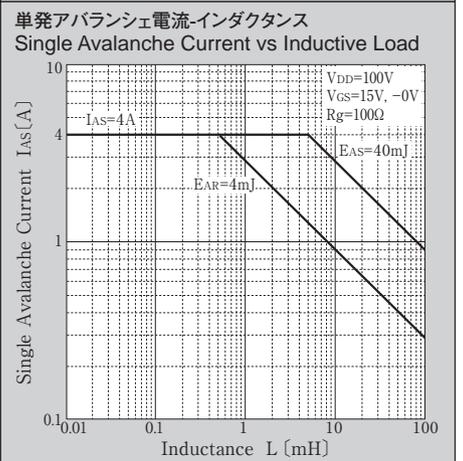
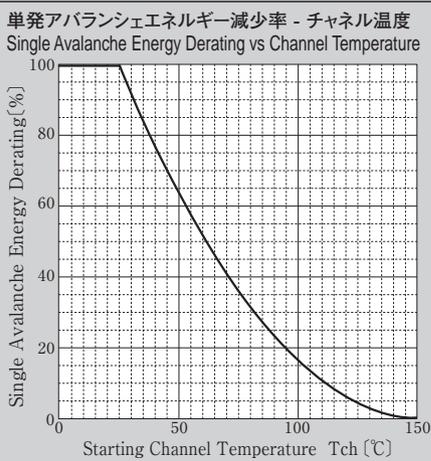
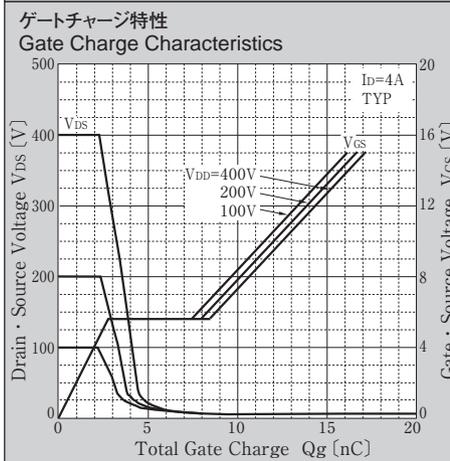
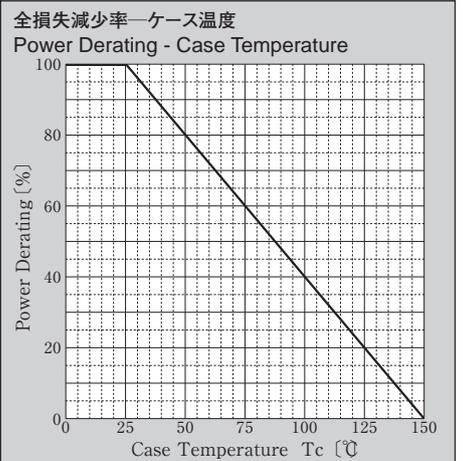
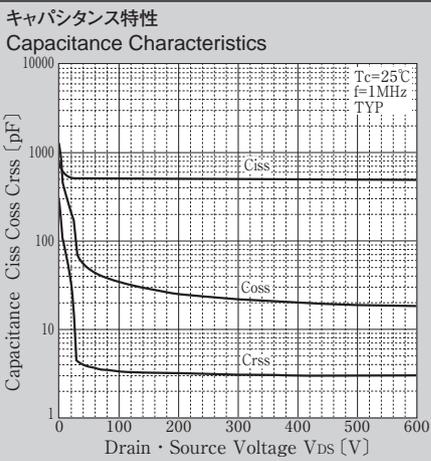
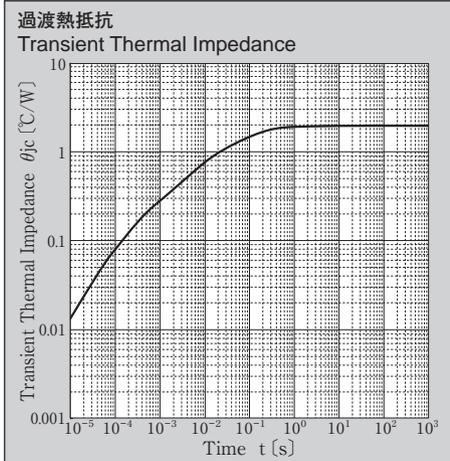
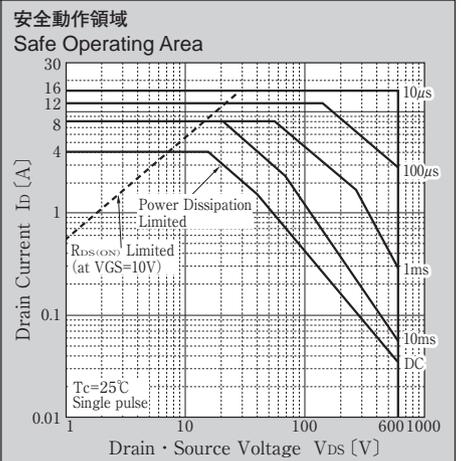
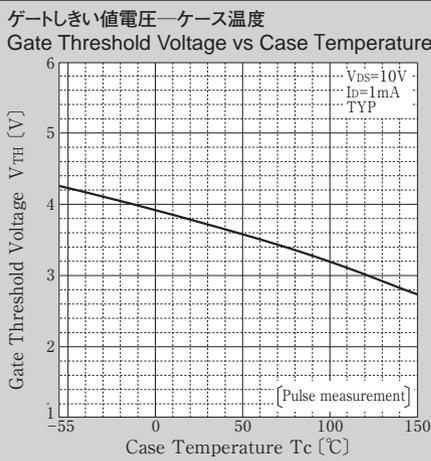
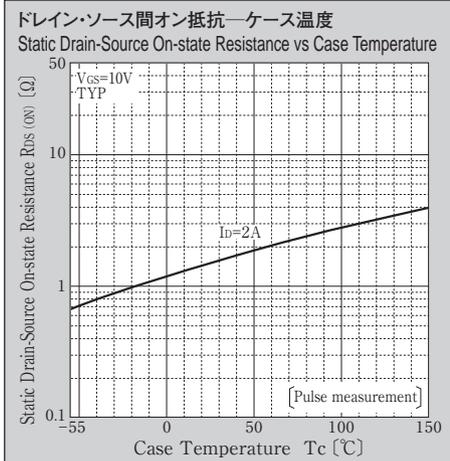
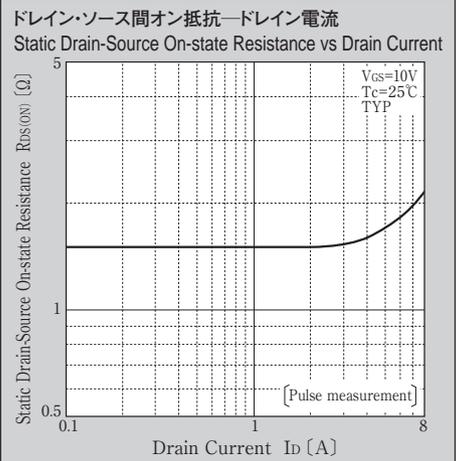
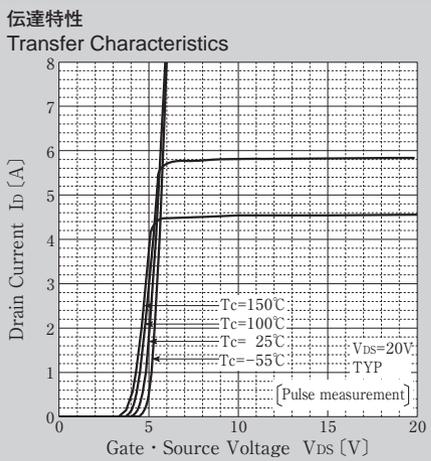
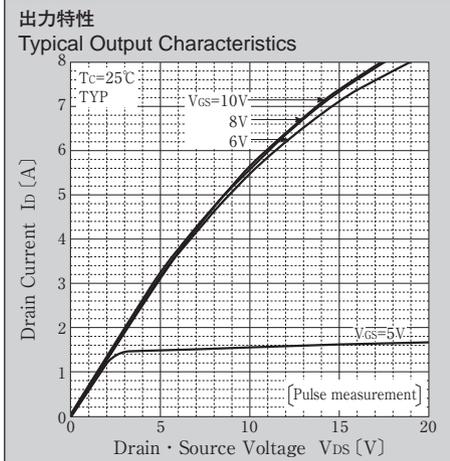
● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_c = 25°C / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}		- 55 ~ 150			°C
チャネル温度 Channel Temperature	T _{ch}		150			
ドレイン・ソース間電圧 Drain-Source Voltage	V _{DSS}		600			V
ゲート・ソース間電圧 Gate-Source Voltage	V _{GSS}		± 30			
ドレイン電流 (直流) Continuous Drain Current (DC)	I _D		4			A
ドレイン電流 (ピーク) Continuous Drain Current (Peak)	I _{DP}	パルス幅 10 μs, duty = 1/100 Pulse width 10 μs, duty = 1/100	16			
ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		4			W
全損失 Total Power Dissipation	P _T		62.5			
繰り返しアバランシェ電流 Repetitive Avalanche Current	I _{AR}	Starting T _{ch} = 25°C, T _{ch} ≤ 150°C	4			A
単発アバランシェエネルギー Single Avalanche Energy	E _{AS}	Starting T _{ch} = 25°C, T _{ch} ≤ 150°C	40			mJ
繰り返しアバランシェエネルギー Repetitive Avalanche Energy	E _{AR}	Starting T _{ch} = 25°C, T _{ch} ≤ 150°C	4			mJ
ドレイン・ソースダイオード耐量 Drain-Source Diode di/dt	di/dt	I _S = 4A, T _c = 25°C	350			A/μs
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2			kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 0.3N·m) (Recommended torque : 0.3N·m)	0.5			N·m

● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T_c = 25°C / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
ドレイン・ソース間降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	600	—	—	V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} = 600V, V _{GS} = 0V	—	—	100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} = ± 25V, V _{DS} = 0V	—	—	± 10	
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D = 2A, V _{DS} = 10V	2.5	5.0	—	S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{(DS)ON}	I _D = 2A, V _{GS} = 10V	—	1.5	1.8	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D = 1mA, V _{DS} = 10V	3.0	3.75	4.5	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S = 2A, V _{GS} = 0V	—	—	1.5	
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	—	—	2	°C/W
ゲート全電荷量 Total Gate Charge	Q _g	V _{DD} = 400V, V _{GS} = 10V, I _D = 4A	—	12.5	—	nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} = 50V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	505	—	pF
掃還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}		—	3.8	—	
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}		—	48	—	
ターンオン遅延時間 Turn-on delay time	td(on)	I _D = 2A, R _L = 75 Ω, V _{DD} = 150V, R _g = 50 Ω, V _{GS(+)} = 10V, V _{GS(-)} = 0V	—	16	—	ns
上昇時間 Rise time	tr		—	10	—	
ターンオフ遅延時間 Turn-off delay time	td(off)		—	40	—	
降下時間 Fall time	tf		—	28	—	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.

ご注意

1. ご採用に際しては、別途仕様書をご請求の上、ご確認をお願いいたします。
2. 本資料に記載されている当社製品の品質水準は、一般的な信頼度が要求される標準用途を意図しています。その製品の故障や誤動作が直接生命や人体に影響を及ぼすような極めて高い品質、信頼度を要求される特別、特定用途の機器、装置にご使用の場合には必ず事前に当社へご連絡の上、確認を得て下さい。当社の製品の品質水準は以下のように分類しております。
 - 【標準用途】
コンピュータ、OA等の事務機器、通信用端末機器、計測器、AV機器、アミューズメント機器、家電、工作機器、パーソナル機器、産業用機器等
 - 【特別用途】
輸送機器(車載、船舶等)、基幹用通信機器、交通信号機器、防災/防犯機器、各種安全機器、医療機器等
 - 【特定用途】
原子力制御システム、航空機器、航空宇宙機器、海中継機器、生命維持のための装置、システム等
3. 当社は品質と信頼性の向上に絶えず努めていますが、必要に応じ、安全性を考慮した冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計等の手段により結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等が防止できるようご検討下さい。
4. 本資料に記載されている内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。製品のご購入に際しましては事前に当社または特約店へ最新の情報をご確認下さい。
5. 本資料の使用によって起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、当社は一切その責任を負いません。
6. 本資料によって第三者または当社の特許権その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
7. 本資料に記載されている製品が、外国為替及び外国貿易管理法に基づき規制されている場合、輸出には同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。
8. 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りいたします。